

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第2区分
 【発行日】平成19年9月20日(2007.9.20)

【公開番号】特開2002-49056(P2002-49056A)
 【公開日】平成14年2月15日(2002.2.15)
 【出願番号】特願2000-232528(P2000-232528)
 【国際特許分類】

G 0 2 F 1/1368 (2006.01)
G 0 9 F 9/00 (2006.01)
G 0 9 F 9/30 (2006.01)
H 0 4 N 5/66 (2006.01)
H 0 1 L 29/786 (2006.01)

【F I】

G 0 2 F 1/1368
 G 0 9 F 9/00 3 4 8 C
 G 0 9 F 9/30 3 1 0
 G 0 9 F 9/30 3 3 8
 H 0 4 N 5/66 1 0 2 A
 H 0 1 L 29/78 6 1 2 B
 H 0 1 L 29/78 6 2 6 C

【手続補正書】

【提出日】平成19年7月25日(2007.7.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

金属表面を有する基板の端部を曲げて基板ホルダーに固定し、
 前記金属表面を有する基板上に絶縁膜を形成し、
 前記絶縁膜上にTFT及び画素電極を形成し、
 前記画素電極上に接着層を用いて固定基板を貼り合わせ、
 前記基板ホルダーを分離することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項2】

金属表面を有する基板の端部を曲げて基板ホルダーに固定し、
 前記金属表面を有する基板上に絶縁膜を形成し、
 前記絶縁膜上にTFT及び画素電極を形成し、
 前記画素電極上に接着層で固定基板を貼り合わせ、
 前記金属表面を有する基板の端部を切断することにより、前記基板ホルダーを分離することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項3】

請求項1または請求項2において、前記金属表面を有する基板は真空中で固定することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項4】

請求項1乃至請求項3のいずれか一において、前記金属表面を有する基板は室温～400で固定することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項5】

請求項 1 乃至請求項 4 のいずれか一において、前記基板ホルダーの端部は曲面を有していることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 6】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか一において、前記基板ホルダーは、前記金属表面を有する基板と同じ熱膨張係数を有することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 7】

請求項 1 乃至請求項 6 のいずれか一において、前記金属表面を有する基板は、ステンレス基板であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 8】

請求項 7 において、前記ステンレス基板の厚さは $10\ \mu\text{m} \sim 30\ \mu\text{m}$ であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 9】

請求項 1 乃至請求項 8 のいずれか一において、前記基板ホルダーは、ステンレス基板であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 10】

請求項 9 において、前記ステンレス基板の厚さは $500\ \mu\text{m} \sim 1000\ \mu\text{m}$ であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 11】

請求項 1 乃至請求項 10 のいずれか一において、前記画素電極と前記固定基板との間に液晶を備えることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 12】

請求項 1 乃至請求項 11 のいずれか一に記載された半導体装置とは、反射型の液晶表示装置であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 13】

金属表面を有する基板と前記金属表面を有する基板上に設けられた絶縁膜と、前記絶縁膜上に駆動回路及び画素部と、前記金属表面を有する基板に対向する対向基板と、前記対向基板と前記金属表面を有する基板との間に備えられた液晶と、を有することを特徴とする半導体装置。

【請求項 14】

金属表面を有する基板と前記金属表面を有する基板上に設けられた絶縁膜と、前記絶縁膜上に駆動回路及び画素部と、前記金属表面を有する基板に対向する対向基板と、前記対向基板と前記金属表面を有する基板との間に備えられた液晶と、を有する半導体装置であって、

前記金属表面を有する基板の端部を曲げて基板ホルダーに固定した状態で、前記駆動回路及び前記画素部は形成されることを特徴とする半導体装置。

【請求項 15】

請求項 13 または請求項 14 において、前記金属表面を有する基板は、ステンレス基板であることを特徴とする半導体装置。

【請求項 17】

請求項 15 において、前記ステンレス基板の厚さは $10\ \mu\text{m} \sim 30\ \mu\text{m}$ であることを特徴とする半導体装置。

【請求項 18】

請求項 13 乃至請求項 17 のいずれか一において、前記金属表面を有する基板の表面粗さは、 $1\ \mu\text{m R M A X}$ 以下であることを特徴とする半導体装置。

【請求項 19】

請求項 13 乃至請求項 17 のいずれか一において、前記金属表面を有する基板の表面に存在する凸部の曲率半径は、 $1\ \mu\text{m}$ 以上であることを特徴とする半導体装置。

【請求項 20】

請求項 13 乃至 19 のいずれか一に記載された半導体装置とは、反射型の液晶表示装置であることを特徴とする半導体装置。